

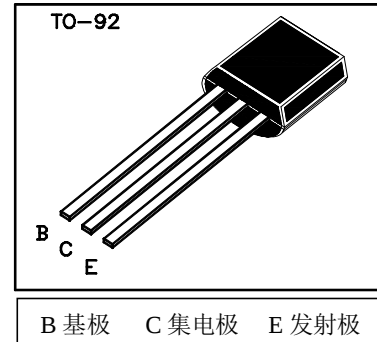
13001-2 NPN 功率三极管

* 主要用途:

电子镇流器、节能灯、充电器及各类功率开关电路。

* 主要特点:

硅三重扩散平面工艺、输出特性好、电流容量大。

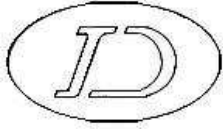


极限值: (Tc=25℃)

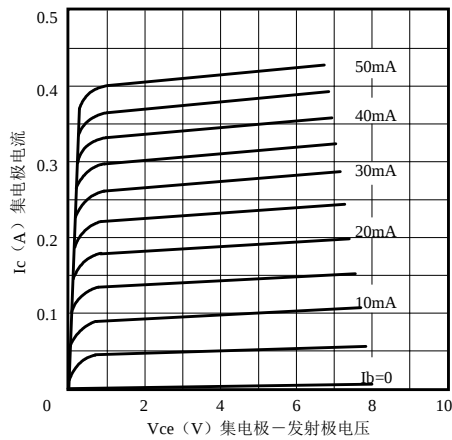
参 数 名 称	符 号	额 定 值	单 位
集电极—发射极击穿电压	BV_{CEO}	≥ 400	V
集电极—基极击穿电压	BV_{CBO}	≥ 700	V
发射极—基极击穿电压	BV_{EBO}	≥ 9	V
最大集电极直流电流	I_{cm}	0.45	A
最大耗散功率	P_{cm}	9	W
最高结温	T_{jm}	150	℃
贮存温度	T_{stg}	- 55 ~ 150	℃

电特性: (Tc=25℃)

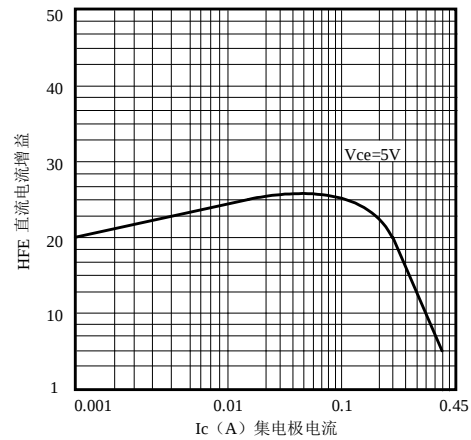
参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值		单 位
			最小值	最大值	
集电极—发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=1mA; I_B=0$	400		V
集电极—基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C=1mA; I_E=0$	700		V
发射极—基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E=1mA; I_C=0$	9		V
集电极—发射极反向漏电流	I_{CEO}	$V_{CE}=380V; I_B=0$		20	μA
集电极—基极反向漏电流	I_{CBO}	$V_{CB}=680V; I_E=0$		10	μA
发射极—基极反向漏电流	I_{EBO}	$V_{EB}=7V; I_C=0$		10	μA
共发射极直流电流增益	H_{FE}	$V_{CE}=5V; I_C=50mA$	15	35	
		$V_{CE}=5V; I_C=1mA$	8		
集电极—发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=0.2A; I_B=0.1A$		0.6	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=10V; I_C=0.1A; f=1MHz$	8		MHz
存储时间	T_s	UI9600; $I_C=100mA; I_b=1mA$	1.5	2.0	μS



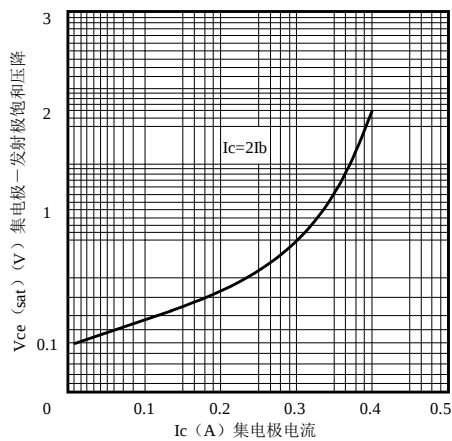
静态输出特性



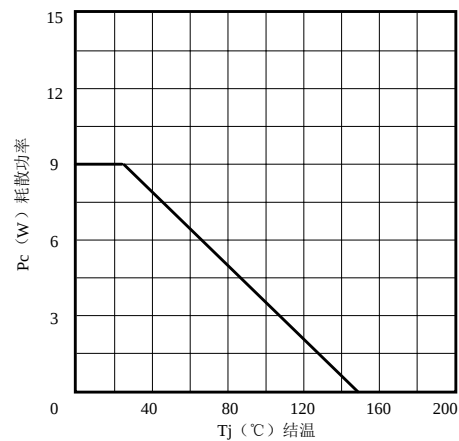
HFE 直流电流增益 - I_c 集电极电流



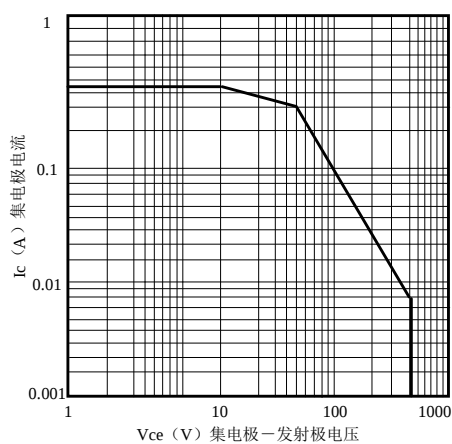
$V_{ce(sat)}$ 集电极-发射极饱和压降 - I_c 集电极电流



P_c 耗散功率 - T_j 结温



SOA (DC) 安全工作区





封装形式:

TO-92 (单位: mm, 无其他特别说明公差 $\pm 0.1\text{mm}$)

